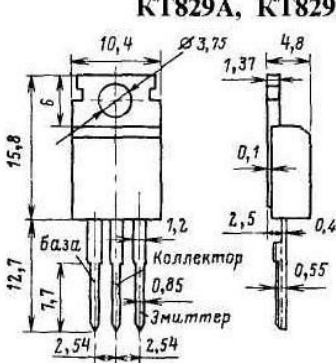


КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г



Транзисторы кремниевые меза-плаиарные *n-p-n* составные универсальные низкочастотные мощные

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 2 г

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_K = 100$ мА не менее:

КТ829А	100 В
КТ829Б	80 В
КТ829В	60 В
КТ829Г	45 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 3,5$ А, $I_B = 14$ мА не более 2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 3,5$ А, $I_B = 14$ мА не более 2,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_K = 3$ А не менее

при $T_K = 298$ К и $T_K = 358$ К	750
при $T_K = 233$ К	100

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 10$ МГц, $U_{КЭ} = 3$ В, $I_K = 3$ А не менее 0,4

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ макс}$

$R_{БЭ} = 1$ кОм не более	
при $T_K = 298$ К и $T = 233$ К	1,5 мА
при $T_K = 358$ К	3 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В не более 2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм, постоянное напряжение коллектор-база

КТ829А	100 В
КТ829Б	80 В
КТ829В	60 В
КТ829Г	45 В

Постоянное напряжение база-эмиттер 5 В

Постоянный ток коллектора 8 А

Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 500$ мкс, $Q \geq 10$ 12 А

Постоянный ток базы 0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K \leq 298$ К 60 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус 2,08 К/Вт

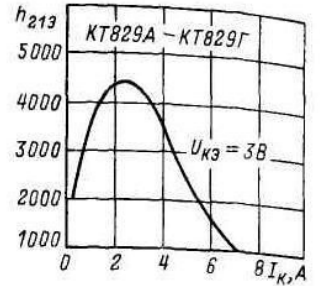
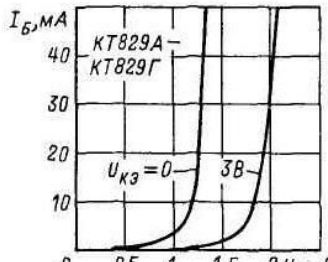
Температура перехода 423 К

Температура окружающей среды От 233 до $T_K = 358$ К

Примечания 1 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, при $T_K = 298 - 358$ К рассчитывается по формуле

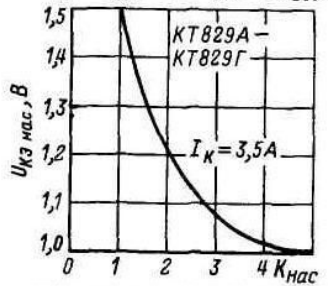
$$P_{K макс} = (423 - T_K)/2,08.$$

2 Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора, при этом температура корпуса не должна превышать 358 К.

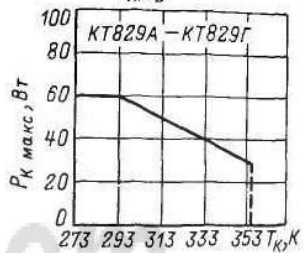
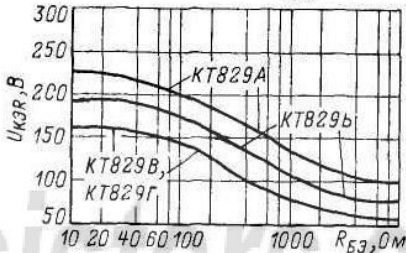


Входные характеристики

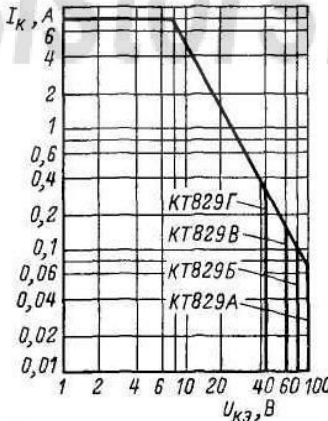
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от I_K/I_B



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер



Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.

Область максимальных режимов

Для улучшения теплового контакта рекомендуется смачивать нижнее основание транзистора полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-100 ГОСТ 13032-77

Температура корпуса транзистора измеряется на поверхности основания корпуса со стороны держателя.